

GDT 气体放电管



浪拓电子电路保护 GDT (气体放电管) 并联在电源线、电信线、信号线和数据传输线等敏感通讯设备的前端，进而保护它们免受因闪电和设备开关操作引起的瞬间浪涌电压的破坏。正常情况下，这些器件并不会影响信号的正常工作。在过压情况下，GDT 可转换到低阻状态，使能量离开敏感的设备。

GDT 气体放电管提供高水准的浪涌保护，具有多种电压、低电容和形状，包括新型的 表面贴装式器件，适用于 MDF (主配线架) 模组、高速数据电信 (例如 ADSL、VDSL)，以及电源线的浪涌保护等应用。在与 PTC 自复式器件配合使用的综合电路保护方案中，它们能帮助设备厂家符合最严格的安全标准。

特性：

- 符合 RoHS 规范
- 无卤素器件 (溴 \leq 900ppm, 氯 \leq 900ppm, 溴+氯 \leq 1500ppm)
- 多种电压选择 (75V-3600V)
- 外形多样化 (3mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 11mm, 16mm 直径)
- 电容及插入损耗低
- 具有低弧光电压的过压保护器件，无放射性材料
- 较高精度的放电电压，适用于高精密设计
- 不同引线形状和表面贴装式选择
- 可选择失效保护机构，符合 UL497B 和 UL1449 认证，依据 ITU K.12 测试

TSS 半导体放电管



浪拓电子电路保护 TSS（半导体放电管）系列浪涌抑制器增加了新的产品。这些新的双向半导体放电管扩大了电压提供范围并降低了电容值，可用于保护高速 ADSL / VDSL 调制解调器、以太网和以太网供电电路和其他高速通信设备，防止它们因为过电压而受到损坏。

新的半导体放电管符合 GR-1089 Core、ITU K.20/K.21、

IEC61000-4-5、FCC 第 68 章以及 UL60950 等主要标准，并能对行业标准中的 50A、80A、100A、200A（10/1000 μ s）系列的浪涌电流提供快速的双向保护。

器件的关键性参数：电压范围从 6 V 至 750 V，电容低至 12 pF，最大漏电流仅 2 μ A，最小保持电流为 150 毫安。器件有 SMB（JEDEC DO-214AA）和 SMA（JEDEC DO-214AC）以及 SMB-T 三种表面贴装封装可供选择。

半导体放电管能够保护敏感的电信设备和数据通信设备，防止包括雷击在内的瞬态过电压事件造成的损坏，在浪涌电压超过器件击穿电压时起分流作用。当浪涌电压超过击穿电压时，半导体放电管工作在保护特性曲线的低阻区，形成一个低阻通路，有效地降低过电压。半导体放电管器件保持低阻状态直到流过该器件的电流下降到低于保持电流。在过电压事件过去之后，半导体放电管器件自动恢复到高阻状态，系统正常工作。

半导体放电管器件除了自恢复功能以外，还有尺寸小，通态功耗低，击穿电压准确等特点。新推出的器件电容小，适合在高速数据传输的电路中使用。

该器件符合 RoHS 的要求，与无铅焊接和大批量贴装的工艺过程兼容，可用于保护通信网络设备，包括模拟和数字线路卡、XDSL 和 ISDN 调制解调器、机顶盒、T1 设备以及 VoIP 设备等。